

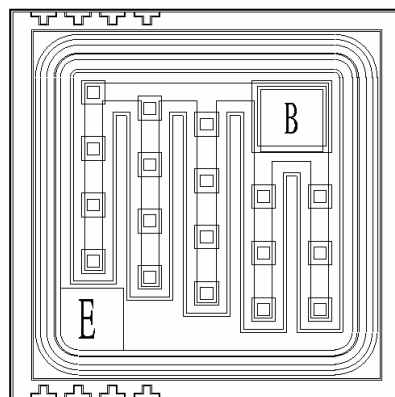


# 8050L 晶体管芯片说明书

## 芯片简介

- 芯片尺寸：4 英寸（100mm）
- 芯片代码：C065BJ-00
- 芯片厚度：240 ± 20μm
- 管芯尺寸：650 × 650μm<sup>2</sup>
- 焊位尺寸：B 极 105×105μm<sup>2</sup>；E 极 105×105μm<sup>2</sup>
- 电极金属：铝
- 背面金属：金
- 典型封装：S8050，H8050L

## 管芯示意图



## 极限值 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-92)

- T<sub>stg</sub>——贮存温度..... -55~150
- T<sub>j</sub>——结温..... 150
- P<sub>C</sub>——集电极耗散功率.....1W
- V<sub>CBO</sub>——集电极—基极电压.....40V
- V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压.....25V
- V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压.....6V
- I<sub>C</sub>——集电极电流.....1.5A

## 电参数 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I <sub>CBO</sub>	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V <sub>CB</sub> =35V, I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V <sub>EB</sub> =6V, I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直流电流增益	85		500		V <sub>CE</sub> =1V, I <sub>C</sub> =100mA
		40				V <sub>CE</sub> =1V, I <sub>C</sub> =800mA
V <sub>BE(on)</sub>	基极—发射极导通电压			1.0	V	V <sub>CE</sub> =1V, I <sub>C</sub> =10mA
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压		0.2	0.5	V	I <sub>C</sub> =800mA, I <sub>B</sub> =80mA
V <sub>BE(sat)</sub>	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I <sub>C</sub> =800mA, I <sub>B</sub> =80mA
BV <sub>CBO</sub>	集电极—基极击穿电压	40			V	I <sub>C</sub> =100μA, I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	25			V	I <sub>C</sub> =2mA, I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	6			V	I <sub>E</sub> =100μA, I <sub>C</sub> =0
f <sub>T</sub>	特征频率	100			MHz	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =50mA